## **SEPTO** 12 OCT 2004

(12)特許協力条約に基づいて公開さ

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2003年10月23日(23.10.2003)

**PCT** 

(10) 国際公開番号

WO 03/087747 A1

(51) 国際特許分類?:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/04714

G01L 1/18, H01L 29/84

(22) 国際出願日:

2003 年4 月14 日 (14.04.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特厘2002-111396 2002 年4 月12 日 (12,04,2002) JP 特願 2002-305186

2002年10月18日(18.10.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 北陸電気 工業株式会社 (HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒939-2292 宮山県 上新川郡 大沢 野町下大久保3158番地 Toyama (JP).

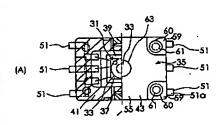
(72) 発明者; および

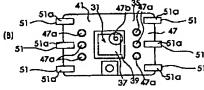
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 広瀬茂 (田-ROSE,Shigeru) [JP/JP]; 〒939-2292 富山県 上新川郡 大沢野町下大久保3158番地 北陸電気工業株式会 社内 Toyama (JP). 沢村 博之 (SAWAMURA,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒939-2292 宮山県 上新川郡 大沢野町下大 久保3168番地 北陸電気工業株式会社内 Toyama (JP). 安藤 正人 (ANDO,Masato) [JP/JP]; 〒939-2292 富 山県 上新川郡 大沢野町下大久保3158番地 北 陸電気工業株式会社内 Toyama (JP). 本木 幹三 (MO-TOKI, Yoshimitsu) [JP/JP]; 〒939-2292 富山県 上新川 郡 大沢野町下大久保3158番地 北陸電気工業株 式会社内 Toyama (JP).

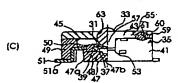
/链菜有?

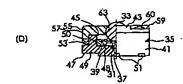
(54) Title: SEMICONDUCTOR FORCE SENSOR

(54) 発明の名称: 半導体カセンサ









(57) Abstract: A semiconductor force sensor capable of preventing a diaphragm part (37) from being broken and accurately measuring a force applied thereto in a direction orthogonal to the diaphragm part (37), wherein a force transmitting means for applying a measured force to the diaphragm part (37) of a semiconductor force sensor element (31) is formed of a sphere (33) having a rigidity, and a through hole (63) passing through an opposed wall part (55) toward the diaphragm (37) is formed in the opposed wall parts (55) at a position opposed to the center part of the diaphragm part (37) so that a part of the sphere (33) can face the outside of the opposed wall part (55) and stores a part of the remaining part of the sphere (33) to allow the sphere (33) to be moved only in a direction orthogonal to the diaphragm part (37) and rotated on the center part of the diaphragm part (37).

ダイアフラム部37が破損するのを防ぐことができ、 しかもダイアフラム部37と直交する方向に加わる力を正確に測 定できる半導体力センサを提供する。半導体力センサ素子31の ダイアフラム部37に測定の対象となる力を加えるための力伝達 手段を剛性を有する球体33により構成する。対向壁部55のダイ アフラム部37の中心部と対向する位置に、ダイアフラム部37に 向かう方向に対向壁部55を貫通する貫通孔63を形成する。貫 通孔63は、球体33の一部を対向壁部55の外部に臨ませ、球 体33がダイアフラム部37と直交する方向にのみ移動可能で且 つ球体33がダイアフラム部37の中心部上で回動し得るように 球体33の残部の一部を収容する形状を有するように形成する。